

ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ОПРОМІНЮВАННЯ ШВИДКИМИ НЕЙТРОНАМИ ТА ШВИДКИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ НА ТЕМПЕРАТУРНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ КЕРАМІКИ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

В. А. МОКРИЦЬКИЙ, А. О. САВЕЛЬЄВ

УДК 537.312.62

© 1998 р.

Одеський державний політехнічний університет
(270044 Одеса 44, просп. Шевченка, 1)

Досліджується вплив швидких нейtronів та швидких електронів на властивості високотемпературної надпровідності кераміки $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$. Дози опромінювання становлять $10^{11} - 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Проведено порівняльний аналіз результатів опромінювання для двох типів випромінювання. Обговорюються можливі причини зміни властивостей надпровідного переходу під впливом швидких нейtronів.

Вступ.

Вивчення радіаційних ефектів у високотемпературних надпровідниках (ВТНП) пов'язане з вирішенням багатьох питань практичного застосування випромінювання. Успішне застосування випромінювання обумовлене досягненнями радіаційної фізики твердого тіла у визначенні механізмів утворення первинних радіаційних дефектів, кінетики їх нагромадження, взаємодії між ними та із структурними дефектами, впливу умов опромінювання на дійсну дефектну структуру матеріалів та зміну їх фізичних властивостей у процесі старіння та відпалу. Дослідження впливу радіації на ВТНП для використання опромінювання як технологічного фактора почали проводитися регулярно тільки в останні роки.

У цій роботі досліджується поведінка ВТНП-кераміки під впливом радіаційного опромінювання дозами від 10^{11} до 10^{16} см^{-2} . Більше цього інтервалу обумовлений тим, що під час "малих" доз ще не відбувається глобального руйнування структури матеріалу (концентрація радіаційних дефектів не перевищує концентрації власних), але відбуваються зміни деяких властивостей матеріалу, якими можна керувати. Метою роботи є виявлення можливості використання різних видів опромінювання для направлена зміни властивостей матеріалу.

1. Експеримент

Для досліджень вибрано високотемпературну надпровідну кераміку $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ (1 — 2 — 3). Технологія виготовлення даного матеріалу достатньо

проста та дозволяє отримувати зразки з параметрами, які добре відтворюються. Кераміку виготовлено з порошків YO_2 , Ba_2CO_3 та CuO_2 марки ОСЧ за стандартною технологією. Якість фази (1 — 2 — 3) контролювалася за допомогою рентгенофазового аналізу. Отримані таким чином зразки мали температуру переходу $T_c = 91 + 92 \text{ K}$, ширину надпровідного переходу $\Delta T_c = 3 \text{ K}$, критичну густину струму $J_c = 200 + 400 \text{ A/cm}^2$.

Для визначення транспортних характеристик (T_c , ΔT_c та J_c) на зразки наносили контакти впіленням срібної пасті при температурі $400 - 450^\circ\text{C}$.

Температуру надпровідного переходу T_c визначали з температурної залежності опору $R(T)$ за точкою, коли опір зразка становив половину від свого значення при $T = 95 \text{ K}$. Вимірювання опору R проводилося чотириконтактовим методом, що дозволило виключити вплив опору контактів. Похибка вимірювання опору зразків становила не більше ніж 1 %. Вимірювання проводилося при температурі від 80 до 300 K. Похибка визначення температури не більша ніж 0,1 K.

Опромінювання здійснювалося при 290 K. Експозиційну дозу опромінювання регулювали зміною часу опромінювання. Кожний зразок опромінювався одноразово.

Інтенсивність пучка швидких нейtronів становила $1,5 \cdot 10^8 1/(\text{с} \cdot \text{см}^2)$, енергія — 14 MeV. Було використано дози: $10^{11}, 10^{13}, 10^{14}, 10^{15}, 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$. Енергія швидких електронів становила 2,7 MeV. Дози: $10^{12}, 10^{13}, 10^{14}, 10^{15}, 10^{16} \text{ см}^{-2}$.

2. Результати експерименту

2.1. Вплив електронів

Залежність зміни опору кераміки у нормальному стані від дози опромінювання не спостерігається. Опір збільшується, як правило, у межах 0 — 1 %. Поблизу надпровідного переходу результати опромінювання швидкими електронами одинаковими

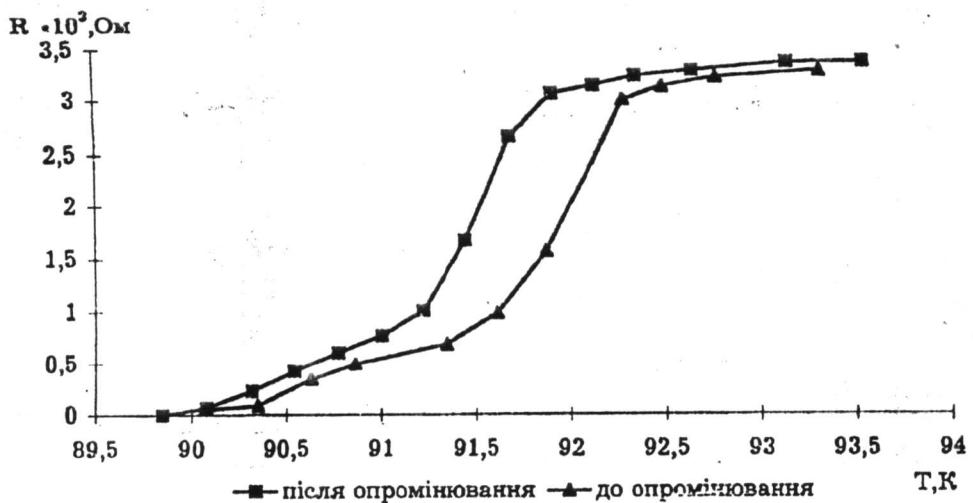


Рис.1. Вплив опромінення швидкими нейtronами (дозою 10^{15} см^{-2}) на температурну залежність опору $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

дозами суттєво відрізняються для різних зразків. Хоч усі зразки було виготовлено в єдиному технологічному циклі, алс існують деякі неконтрольовані відмінності у властивостях зразків, які приводять до різних результатів. Це значно ускладнює інтерпретацію результатів, і робить ниможливим визначення дозової залежності у зміні параметрів кераміки, що ґрутувалася б на результатах опромінення різних зразків у вибраному діапазоні доз.

Аналіз вихідних параметрів свідчить, що по-перше, зразки дійсно мали такі відмінності, які проявляються у відхиленні вихідної критичної густини струму (у діапазоні від 300 до 340 A/cm^2), по-друге, існує кореляція між значенням вихідної критичної густини струму та значенням зміщення надпровідного переходу під впливом опромінення електронами. Особливо відмітмо збільшення $T_c(\Delta T_c > 0)$ під впливом опромінення різними дозами електронів у зразках, які мають порівняно велику критичну густину струму (більше 320 A/cm^2).

2.2. Вплив нейtronів

Опір ВТНП-зразків у нормальному стані під впливом нейtronів дозами меншими ніж $5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ практично не змінюється, але при більших дозах — зростає. Початкова температура надпровідного переходу зменшується під впливом, будь-якої дози нейtronів. Інколи спостерігається збільшення крутизни надпровідного переходу під впливом різних використаних доз опромінення нейtronами (рис.1). У цих зразках спостерігається більш швидке зниження початкової температури надпро-

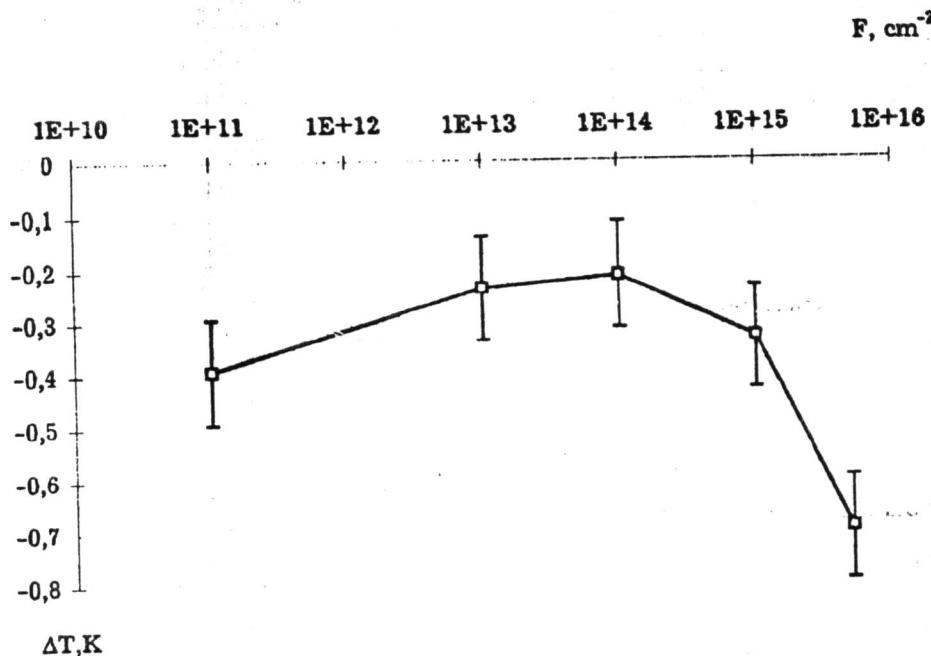
відного переходу ніж кінцевої, що зважує його інтервал.

Повторне вимірювання температурної залежності опору зразків через рік показало, що збереження за нормальних умов на протязі року будь-яких зразків не приводить до помітної зміни властивостей порівняно із зразками тільки що опроміненими.

Результати опромінення нейtronами, на відміну від опромінення електронами, не такі чутливі до структурних властивостей, пов'язаних з критичною густиною струму. Тому можна спостерігати дозову залежність зміни температури надпровідного переходу (рис.2). У роботі не спостерігали очікуваного [1, 2] підвищення температури T_c під впливом нейtronів.

3. Обговорення результатів

У межах вихідної T_c для зразків, що використовувалися у роботі з опроміненням нейtronами, вплив цього параметра на зміщення температури переходу не дуже чіткий. Але порівняння з результатами робіт [1, 2], де використовувалися зразки з вихідною температурою надпровідного переходу $T_c = 88,6 + 91 \text{ K}$, дозволяє зробити висновок, що від останньої залежить не тільки величина зміни ΔT_c а і характер цієї зміни (так у нашій роботі при опроміненні нейtronами не виявлено збільшення T_c у будь-яких умовах). У роботах [1, 2], спостерігається збільшення T_c приблизно на 3 K під впливом опромінення. Але, ймовірно, існує межа для T_c , яку не можливо перевищити шляхом оп-

Рис.2. Дозова залежність ΔT_c після опромінювання швидкими нейtronами

ромінювання зразка, і, якщо ця межа досягнута вже при виготовленні вихідних зразків, то опромінювання нейtronами не може підвищити T_c . Можливо, це пояснює відсутність покращання T_c .

У роботі не досліджувався вплив опромінення нейtronами дозами меншими ніж 10^{11} см^{-2} , але можливо припустити, що крива $\Delta T_c (\Phi)$ (рис.2) із зменшенням дози опромінювання повинна пройти через деякий мінімум і далі досягнути нуля.

Як сказано вище, результати опромінювання електронами та нейtronами відрізняються. Причину такої різниці слід шукати в різних механізмах взаємодії кожного виду опромінювання з речовиною. Під час опромінювання електронами основним типом дефектів, що утворюються є точкові дефекти. Енергія нейtronів значно більша ніж енергія електронів і значно більша ніж порогова енергія створювання точкового дефекту, тому в разі опромінювання нейtronами первинні атоми в свою чергу здатні зміщувати каскад вторинних. Таким чином, існує велика ймовірність, крім створення точкових дефектів, створення складних каскадних комплексів тощо [3].

При опромінюванні електронами створені точкові дефекти мають низьку енергію міграції,

порівняно з енергією міграції складних комплексів та внаслідок цього високі ймовірності як рекомбінації дефекту (під час дії опромінювання та після зупинення опромінювання), так і міграції дефектів до стоків. У кераміках такими стоками можуть бути межі зерен, для монокристалів межі двійникування чи інші кластерні порушення гратки (наприклад включення інших фаз). У результаті цього, відмінності у дії опромінювання нейtronами та слекторонами, що відбувається за все, можуть визначитися наявністю більшої концентрації стійких складних дефектів.

Відсутність змін через рік у разі збереження за нормальних умов свідчить, що у випадку опромінення при температурі 290 К відбувається часткова рекомбінація дефектів вже під час опромінювання. А дефекти, що залишаються, або не впливають на властивості матеріалу і їх рекомбінація не приводить до зміни цих властивостей, або мають стійкий характер та більш високу температуру відпалу. Все це підтверджує висновок зроблений раніше.

Висновки

Таким чином, вплив іонізуючого опромінювання дозами до 10^{16} см^{-2} не приводить до значної деградації властивостей ВТНП-кераміки.

Опромінювання швидкими нейtronами може сприяти зміні таких параметрів матеріалу, як температура та ширина надпровідного переходу. У випадку опромінення електронами зміни параметрів менші, а чутливість до вихідних характеристик матеріалу більша, ніж у разі опромінення нейtronами.

Результати цієї роботи доводять, що опромінювання нейtronами може стати засобом керування властивостями керамічних ВТНП — можливість та ефективність цього залежить від вихідних властивостей матеріалу.

За рахунок стійкості дефектів введення дефектної структури добре піддається контролю і, таким чином, добре відтворюється. Це робить можливим використання опромінення нейtronами як ефективного технологічного фактора.

Опромінення електронами, на нашу думку, є більш чутливим методом впливу на матеріал, і результати опромінення дуже сильно залежать від вихідних параметрів кераміки.

1. Алексенко А. А., Букалов А. В., Галушка А. П. и др. // Сверхпроводимость. Физика, химия, технология. — 1992. — 5, №1. — С.100 — 102.
2. Адонікін В. Т., Олексієнко Б. В., Галушка О. П. та ін. // УФЖ. — 1993. — 38. — С.1359 — 1562.
3. Вавилов В. С., Ухін Н. А. Радиационные эффекты в полупроводниках и полупроводниковых приборах. — М.: Атомиздат, 1969.

Одержано 13.02.97,
в остаточному варіанті — 11.07.97

ВЛІЯННЯ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕННЯ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ И БЫСТРЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

В. А. Мокрицкий, А. А. Савельев

Резюме

Исследуется влияние быстрых нейтронов и быстрых электронов на свойства высокотемпературной сверхпроводящей керамики $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$. Дозы облучения составляют $10^{11} - 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Проводится сравнительный анализ результатов облучения для двух типов излучений. Обсуждаются возможные причины изменений свойств сверхпроводящего перехода под действием быстрых нейтронов.

INFLUENCE OF SMALL-DOSE IRRADIATION BY FAST NEUTRONS AND FAST ELECTRONS ON THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF RESISTANCE OF CERAMICS $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

V. A. Mokritsky, A. A. Savelev

Odessa State Polytechnical University
(1, Shevchenko Prospl., Odessa 270044, Ukraine)

Summary

The influence of fast neutrons and fast electrons on properties of high-temperature superconducting ceramics $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ is observed. Irradiation fluences from 10^{11} to 10^{16} cm^{-2} are used. Comparative analysis of results for both types of radiations is carried out. The probable reasons for changes in the superconductivity transition properties under the action of fast neutrons are offered.

Співачки

*B. Mokritsky — В. А. Мокрицкий
A. A. Savelev — А. А. Савельев*